

5584АП7Т

Восьмиканальный двунаправленный приёмо-передатчик со схемой удержания информации на входе и тремя состояниями на выходе

Микросхемы представляют собой быстродействующую логическую схему, изготовленную по КМОП технологии и предназначенную для использования в высокопроизводительных вычислительных системах с широким диапазоном напряжения питания.

Микросхемы допускают возможность работы в режиме превышения напряжения по входу до 7 В без ухудшения характеристик и надежности микросхем. Данная возможность позволяет использовать микросхемы в радиоэлектронных устройствах для сопряжения микросхем с напряжениями питания 5 В и 3 В, исключает выход из строя микросхемы при аварийном отключении источника напряжения питания.

Применение блока формирования выходного фронта в составе микросхемы позволяет уменьшить амплитуду помех при одновременном переключении выходов в одно и то же состояние.

Входные и выходные уровни микросхем соответствуют уровням КМОП.

Особенности:

- Диапазон напряжения питания от 2.0 до 5.5 В.
- Выходной ток 12 мА.
- Низкий ток потребления: 0.2 мкА (типичное значение) при $T_a = 25^\circ\text{C}$.
- Допустимое значение статического потенциала не менее 2000 В.
- Диапазон рабочих температур среды от минус 60 до плюс 125 $^\circ\text{C}$.
- Сбалансированная задержка распространения сигнала.
- Обеспечивает режим превышения напряжения по входу.
- Низкий уровень шума при одновременном переключении выходов в одно и то же состояние:
 $V_{OLP} = 0.8 \text{ В (max)}$.

Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы не регламентируется.

Наиболее близкими по составу параметров разрабатываемой схемы являются микросхемы серии 74VHCxxx ф. Toshiba, Япония, прямой аналог отсутствует.

Микросхема изготавливается в 20-выводном металлокерамическом корпусе типа 4153.20-6.

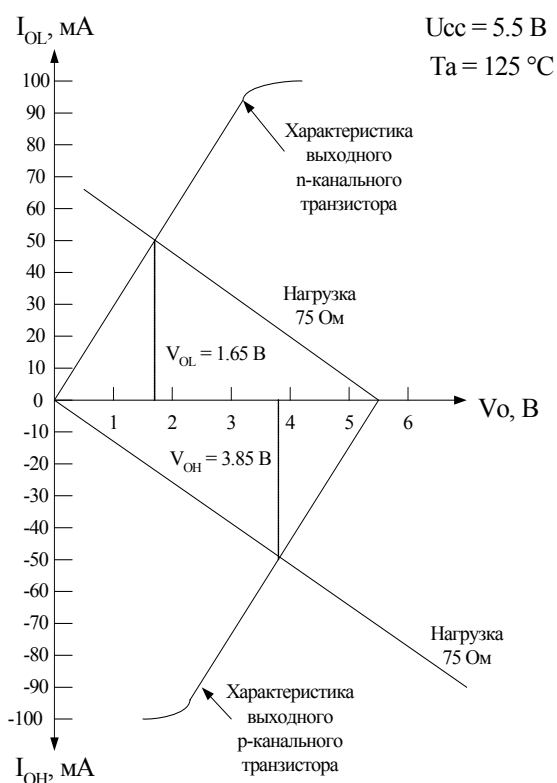
Первый вывод расположен в левом нижнем углу при правильно ориентированной для чтения маркировке.

Микросхемы должны быть стойкими к воздействию специальных факторов согласно таблице

Условное обозначение микросхемы	Группа исполнения для специального фактора						
	7И1	7И6	7И7	7С1	7С4	7К1	7К4
5584xxxxТ	3Ус	4Ус	0.2×5Ус	10×1Ус	1Ус	5×1К	0.5×1К

Предельно допустимые и предельные режимы

Наименование параметров режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		Норма		Норма	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	U_{CC}	2.0	5.5	-0.5	7.0
Входное напряжение низкого уровня, В, – при $U_{CC} = 2.0$ В	U_{IL}	0	0.5	–	–
– при $U_{CC} = (3.0 - 5.5)$ В		0	$0.3U_{CC}$		
Входное напряжение высокого уровня, В, – при $U_{CC} = 2.0$ В	U_{IH}	1.5	U_{CC}	–	–
– при $U_{CC} = (3.0 - 5.5)$ В		$0.7U_{CC}$	U_{CC}		
Входное напряжение, В	U_I	0	5.5	-0.5	10.0
Напряжение, прикладываемое к выходу, В	U_O	0	U_{CC}	-0.5	$U_{CC} + 0.5B$, 10 В ¹⁾
Напряжение, прикладываемое к выходу в режиме превышения ²⁾ , В	U_{OPD}	0	5.5	0	10.0
Входной ток диода, мА, $U_I \leq -0.5$ В	I_{IK}	–	–	–	$ -25 $
Выходной ток диода, мА, $U_O < -0.5$ В, $U_O > U_{CC} + 0.5$ В	I_{OK}	–	–	–	$ \pm 25 $
Выходной ток низкого уровня, мА	I_{OL}	–	12	–	–
Выходной ток высокого уровня, мА	I_{OH}	–	$ -12 $	–	–
Постоянный ток вывода питания или общего вывода, мА	I_{CC}, I_{GND}	–	–	–	100
Длительность фронта, спада входного сигнала (за исключением входов триггера Шмитта), нс	t_{LH}, t_{HL}	–	3 ³⁾	–	–
Емкость нагрузки, пФ	C_L	–	50	–	500
¹⁾ Предельный режим от ($U_{CC} + 0.5$ В) до 10 В допускается, когда выход микросхемы находится в состоянии "Выключено".					
²⁾ Режим превышения: $U_{CC} = 0$ В.					
³⁾ Длительность фронта, спада входного сигнала (без гарантии динамических параметров) не более 300 нс при $U_{CC} = (3.3 \pm 0.3)$ В, не более 90 нс при $U_{CC} = (5.0 \pm 0.5)$ В					



Допускается подача входных сигналов на микросхемы и их снятие при выключенном источнике питания.

Рекомендуется вывод "Питание" соединять с выводом "Общий" через конденсатор емкостью $0.1 \text{ мкФ} \pm 10\%$.

При эксплуатации незадействованные входы следует подключать к источнику питания или к общему выводу.

Микросхемы по выходу обеспечивают согласование с 75-омной линией. Диаграмма соответствия параметров транзисторов выходных каскадов требованиям передачи сигналов в линию с волновым сопротивлением 75 Ом приведена на рисунке 1.

Допускается подавать на выход в активном состоянии напряжение от $(U_{CC} + 0.5 \text{ В})$ до 10 В с ограничением по току 25 мА.

Сопротивление выходных транзисторов микросхем при условии эксплуатации в соответствии с ТУ соответствует требованию ослабления отраженного сигнала от конечной нагрузки линии с волновым сопротивлением 75 Ом. Наличие запасов для наихудших

условий по параметрам $U_{OL} \leq 1.65 \text{ В}$, $U_{ON} \geq 3.85 \text{ В}$ позволяет обеспечить требуемую помехоустойчивость (на уровне 30 %) при работе на линию с волновым сопротивлением 75 Ом.

Диаграмма соответствия параметров транзисторов выходных каскадов микросхем требованиям передачи сигналов в линию с волновым сопротивлением 75 Ом (для наихудшего случая – передачи сигнала на вход микросхемы без подключения согласующего резистора на конце линии)

Таблица истинности микросхемы

Вход		Вход/выход		Операция
$\overline{EZ}$	SED	Порт А	Порт В	
L	L	Данные с порта В	Передаваемые данные	Передача данных от порта В к порту А
		Предыдущие данные с порта В	Вход/выход отключен	
L	H	Передаваемые данные	Данные с порта А	Передача данных от порта А к порту В
		Вход/выход отключен	Предыдущие данные с порта А	
H	X	Хранение данных с порта А	Хранение данных с порта В	Порты изолированы (выходы в состоянии "Выключено")
Примечание – Информация на входах А и В хранится до подачи очередной информации. L - низкий уровень напряжения; H - высокий уровень напряжения; X - любой уровень напряжения (низкий или высокий)				

Назначение выводов микросхемы

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	SED	Вход сигнала выбора направления передачи данных
02	A1	Вход / выход порта данных A
03	A2	Вход / выход порта данных A
04	A3	Вход / выход порта данных A
05	A4	Вход / выход порта данных A
06	A5	Вход / выход порта данных A
07	A6	Вход / выход порта данных A
08	A7	Вход / выход порта данных A
09	A8	Вход / выход порта данных A
10	GND	Общий вывод
11	B8	Вход / выход порта данных B
12	B7	Вход / выход порта данных B
13	B6	Вход / выход порта данных B
14	B5	Вход / выход порта данных B
15	B4	Вход / выход порта данных B
16	B3	Вход / выход порта данных B
17	B2	Вход / выход порта данных B
18	B1	Вход / выход порта данных B
19	$\overline{EZ}$	Вход разрешения выхода
20	Vcc	Вывод питания от источника напряжения

Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Напряжение питания, U _{CC} , В	Норма параметра		Температура среды, °С	
			не менее	не более		
Выходное напряжение высокого уровня, В, при I _{ОН} = -50 мкА	U _{ОН}	2,0	1,9	—	25±10; -60; 125	
		3,0	2,9			
		4,5	4,4			
при I _{ОН} = -6 мА			3,0		2,58	25±10
			3,0		2,38	-60; 125
при I _{ОН} = -12 мА			4,5		3,94	25±10
			4,5		3,70	-60; 125
Выходное напряжение низкого уровня, В, при I _{ОЛ} = 50 мкА	U _{ОЛ}	2,0	—	0,1	25±10; -60; 125	
		3,0		0,1		
		4,5		0,1		
при I _{ОЛ} = 6 мА				3,0	0,36	25±10
				3,0	0,50	-60; 125
при I _{ОЛ} = 12 мА				4,5	0,36	25±10
				4,5	0,50	-60; 125
Входной ток низкого уровня, мкА	I _Л	5,5		-0,5	25±10	
		5,5		-10,0	-60; 125	
Входной ток высокого уровня, мкА	I _Н	5,5		0,5	25±10	
		5,5		10,0	-60; 125	
Ток потребления, мкА	I _{СС}	5,5		8,0	25±10	
		5,5		160,0	-60; 125	
Выходной ток утечки в режиме превышения, мкА, при U _О = 5,5 В	I _{ОPD}	0		2,0	25±10	
		0		20,0	-60; 125	
Выходной ток низкого уровня в состоянии "Выключено", мкА	I _{ОZL}	5,5		-0,50	25±10	
		5,5		-10,0	-60; 125	
Выходной ток высокого уровня в состоянии "Выключено", мкА	I _{ОZH}	5,5		0,50	25±10	
		5,5		10,0	-60; 125	
Время задержки распространения при включении, выключении, нс, при C _Л = 50 пФ	t _{PHL} , t _{PLH}	3,3±0,3		15,0	25±10	
		5,0±0,5		10,0		
		3,3±0,3	18,0	-60; 125		
		5,0±0,5	13,0			
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние высокого, низкого уровня, нс, при C _Л = 50 пФ	t _{PZH} , t _{PZL}	3,3±0,3	21,0	25±10		
		5,0±0,5	14,0			
		3,3±0,3	25,0	-60; 125		
		5,0±0,5	17,0			
Время задержки распространения при переходе из состояния высокого, низкого уровня в состояние "Выключено", при C _Л = 50 пФ	t _{PHZ} , t _{PLZ}	3,3±0,3	21,0	25±10		
		5,0±0,5	14,0			
		3,3±0,3	25,0	-60; 125		
		5,0±0,5	17,0			
Примечания						
1 Знак "минус" перед значением тока указывает только его направление (вытекающий ток).						
За величину тока принимается абсолютное значение показаний измерителя тока.						
2 Нормы на динамические параметры уточняются до перевода КД на лит. «О»						